

Содержание

• Атомная структура и неэлектронные свойства полупроводников

Ахмедов Г.М.

Фазообразование и фазовые превращения в нанотолщинных пленках системы Bi-Te 1025

• Электронные и оптические свойства полупроводников

Никонюк Е.С., Захарук З.И., Кучма М.И., Шляховый В.Л., Раренко А.И., Юрийчук И.Н.

Релаксационные процессы в проводимости кристаллов $\text{Cd}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Te}$ ($0.02 < x < 0.55$) 1028

Цыпленков В.В., Демидов Е.В., Ковалевский К.А., Шастин В.Н.

Релаксация возбужденных состояний доноров в кремнии с излучением междолинных фононов 1032

Морозова Н.К., Мидерос Д.А., Галстян В.Г., Гаврищук Е.М.

Особенности спектров люминесценции кристаллов ZnS(O) и $\text{ZnS} \cdot \text{Cu(O)}$ с позиций теории непересекающихся зон . 1039

Боднарь И.В.

Исследование монокристаллов тройного соединения CuIn_3Se_5 1046

Гаджиалиев М.М., Пирмагомедов З.Ш.

Влияние магнитного поля на вольт-амперную характеристику гетероперехода $n\text{-GaAs-p-Ge}$ 1050

Агеева Н.Н., Бронева И.Л., Кривоносов А.Н., Налет Т.А.

Цикличность сверхбыстрой автомодуляции спектра поглощения света, возникающей при накачке и стимулированном излучении в GaAs 1053

• Полупроводниковые структуры, границы раздела и поверхность

Макара В.А., Васильев М.А., Стебленко Л.П., Коплак О.В., Курилюк А.Н., Кобзарь Ю.Л., Науменко С.Н.

Вызванные действием магнитного поля изменения примесного состава и микротвердости приповерхностных слоев кристаллов кремния 1061

Лебедев М.В.

Адсорбция метилтиола на поверхности $\text{GaAs}(100)-(2 \times 4)$: квантово-химический анализ из первых принципов . . . 1065

Середин П.В., Домашевская Э.П., Лукин А.Н., Арсентьев И.Н., Винокуров Д.А., Тарасов И.С.

Инфракрасные спектры отражения многослойных эпитаксиальных гетероструктур с погруженными слоями InAs и GaAs 1072

Стамов И.Г., Ткаченко Д.В.

Влияние электрического поля на фотоэффект в барьерах Шоттки на электронном дифосфиде кадмия 1079

Домашевская Э.П., Гордиенко Н.Н., Румянцова Н.А., Середин П.В., Агапов Б.Л., Битюцкая Л.А., Арсентьев И.Н., Вавилова Л.С., Тарасов И.С.

Состав и параметры доменов, образующихся в результате спинодального распада четверных твердых растворов в эпитаксиальных гетероструктурах $\text{GaInP/Ga}_x\text{In}_{1-x}\text{As}_y\text{P}_{1-y}/\text{GaInP/GaAs}(001)$ 1086

• Низкоразмерные системы

Новиков Б.В., Зегря Г.Г., Пелешак Р.М., Даныкин О.О., Гайсин В.А., Талалаев В.Г., Штром И.В., Цырлин Г.Э.

Барические свойства квантовых точек InAs 1094

Васильевский И.С., Галиев Г.Б., Климов Е.А., Мокееров В.Г., Широков С.С., Имамов Р.М., Субботин И.А.

Электрофизические и структурные свойства двусторонне δ -легированных РНЕМТ-гетероструктур на основе $\text{AlGaAs/InGaAs/AlGaAs}$ 1102

Грузинцев А.Н., Редькин А.Н., Якимов Е.Е., Бартохоу К. (Barthou C.)

Краевая люминесценция наностержней ZnO при оптическом возбуждении большой мощности 1110

Филатов Д.О., Круглова М.В., Исаков М.А., Сипрова С.В., Марычев М.О., Шенгуров В.Г., Чалков В.Ю., Денисов С.А.

Фотолюминесценция нанокластеров GeSi/Si , формирующихся в процессе сублимационной молекулярно-лучевой эпитаксии в среде германа 1116

Гуткин А.А., Брунков П.Н., Егоров А.Ю., Жуков А.Е., Конников С.Г.

Эмиссия электронов из многослойных ансамблей вертикально связанных квантовых точек InAs в матрице $n\text{-GaAs}$ 1122

Моисеев К.Д., Михайлова М.П., Яковлев Ю.П., Королев К., Meinning C., McCombe B.

Магнитофотолюминесценция в разьединенном гетеропереходе II типа $n\text{-GaInAsSb/p-InAs}$ 1126

• Аморфные, стеклообразные, пористые, органические, микрокристаллические полупроводники, полупроводниковые композиты

Иванов-Омский В.И., Звонарева Т.К., Фролова Г.С.

Колебательная спектроскопия аморфного углерода, модифицированного Pt 1131

● **Физика полупроводниковых приборов**

Иванов А.М., Строкан Н.Б., Лебедев А.А.

Особенности использования широкозонных полуизолирующих материалов в задачах регистрации ядерного излучения 1135

● **Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур**

Король В.М., Веденяпин С.А., Заставной А.В., Ovchinnikov V.

Диффузия имплантированного натрия в кислородном кремнии 1140

Качурин Г.А., Черкова С.Г., Марин Д.В., Гутаковский А.К., Черков А.Г., Володин В.А.

Влияние интенсивности торможения ионов на дефектообразование при имплантации в нанокристаллы кремния . . 1145

● **Персоналии**

Памяти Людмилы Германовны Лаврентьевой 1150